

半 导 体 学 报

第 13 卷 第 1 期 1992 年 1 月

目 录

- PICTS 方法研究 SI-GaAs 中深能级缺陷性质……龚大卫 陆 昉 孙恒慧 (1)
- 硅中与铝有关能级的研究……周 洁 卢励吾 韩志勇 吴汲安 (8)
- Ge_xSi_{1-x}/Si 应变层超晶格 X-射线双晶衍射的运动学研究……
……段晓峰 冯国光 王玉田 褚一鸣 刘学峰 盛 麓 周国良 (14)
- ZnSe-ZnS 应变超晶格的质量鉴别……江风益 潘传康 范广涵 范希武 (22)
- 用正偏电容测量研究 SBD 的界面态……陈弘毅 (28)
- Ar^+ 激光结晶非晶硅膜电学性质研究……张向东 黄信凡 陈坤基 (36)
- 声电运输器件的沟道特性研究……邹英寅 凌明芳 陈抗生 (42)
- SIMNI/SOI 结构的高温工艺稳定性 ……
……李金华 林成鲁 林梓鑫 薛才广 邹世昌 (49)
- $\mu c-Si: H/a-Si: H$ 多层膜的制备及性质 ……
……郑家贵 冯良桓 蔡 伟 黄天荃 蔡亚平 罗昭和 周心明 (55)
- 研究简报**
- 差值取样谱函数定理及其在研究 MOS 陷阱弛豫效应方面的应用……
……许铭真 谭长华 王阳元 (62)